

## GaN Driving Innovation in Telecom and Beyond

**裴轶 博士 (副总裁)**

**时间:** 2025年3月20日 (星期四) 13:00—14:30

**地点:** 北京大学物理楼中312会议室

### 报告人简介 (About speaker):

2004年北京大学本科毕业, 2009年获加州大学圣巴巴拉分校博士学位。现任苏州能讯高能半导体有限公司技术副总裁。国家重大人才工程-科技创新领军人才, 获江苏五四青年奖章、电子学会科技进步二等奖等。国家第三代半导体技术创新中心技术专家委员会委员, 第三代半导体联盟标准委员会委员, SEMI China GaN工作组组长。IEEE高级会员, 中国电子学会高级会员/青年科学家俱乐部会员, 中国电源学会元器件专业委员会委员, 北京大学/中国科学技术大学/西交利物浦大学研究生校外导师, 江苏省产业教授。研究兴趣包含氮化镓微波和毫米波器件、氮化镓功率器件及应用、氮化镓材料、工艺、可靠性和非线性模型等。承担和参与多项科技部、工信部、发改委重要核心技术攻关项目, 发表和共同发表了100余篇期刊和会议论文, 累计申请专利150余项。



### 摘要 (Abstract):

氮化镓凭借着优异的材料特性, 在器件特性上如发射功率、效率、带宽、工作温度等具有明显优势, 可以有效降低器件尺寸和提升能源效率, 正逐渐取代砷化镓pHEMT和硅的LDMOS在基站、射频能源等市场, 逐渐成为射频半导体功放的首选。报告将从氮化镓材料、工艺、器件、模型、应用等角度介绍相关技术和研讨。

**联系人 (Host):** 杨学林 xlyang@pku.edu.cn

北京大学物理学院凝聚态物理与材料物理所

